

※課題番号 : F-12-RO-0038
※支援課題名 (日本語) : 半導体デバイスにおける高誘電率薄膜形成プロセス開発に関する相談
※Program Title (in English) : The consultation for the development of a process forming a thin film on a semiconductor device
※利用者名 (日本語) : 佐野 敦
※Username (in English) : Atsushi SANO
※所属名 (日本語) : (株)日立国際電気
※Affiliation (in English) : Hitachi Kokusai Electric Inc.

※概要 (Summary) :

半導体デバイスにおける高誘電率薄膜形成プロセス開発に関する中島安理准教授への技術相談

※実験 (Experimental) :

特になし。

※結果と考察 (Results and Discussion) :

今後も高誘電率薄膜形成プロセスの開発につき、精査すべきである旨、確認できました。

※その他・特記事項 (Others) :

半導体デバイスにおける高誘電率薄膜形成プロセス開発に関し、中島安理准教授にご相談頂きました。